

关键指标

频率：8~13GHz
 饱和输出功率：26.5dBm@Pin=12dBm
 功率附加效率：35%@Pin=12dBm
 功率增益：15dB@Pin=12dBm
 小信号增益：16.5dB
 电压/静态电流：+8V/140mA
 芯片尺寸：1.25mm×1.5mm

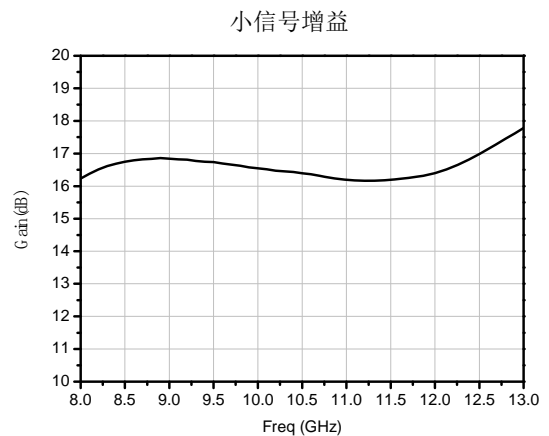
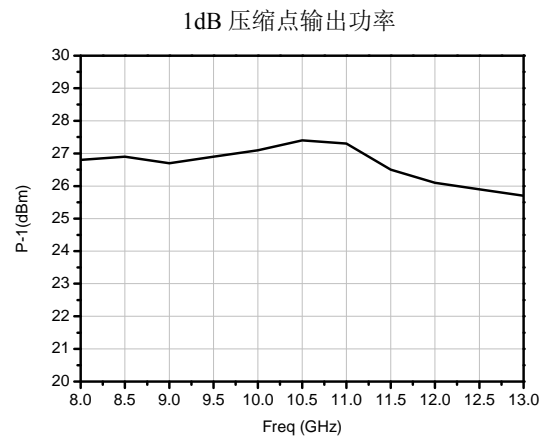
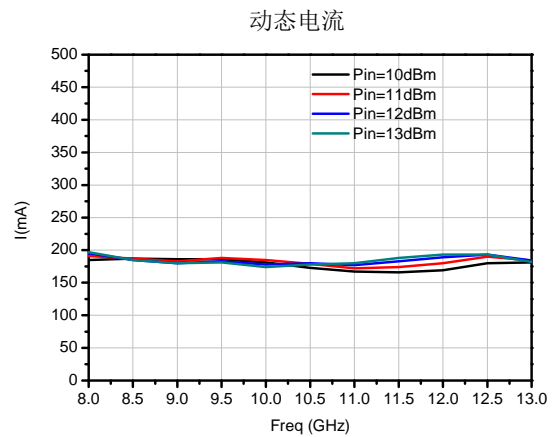
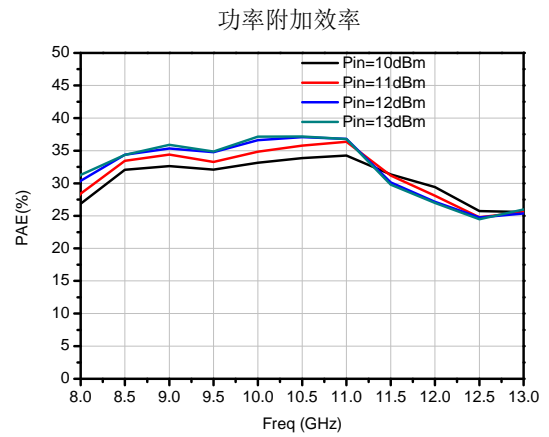
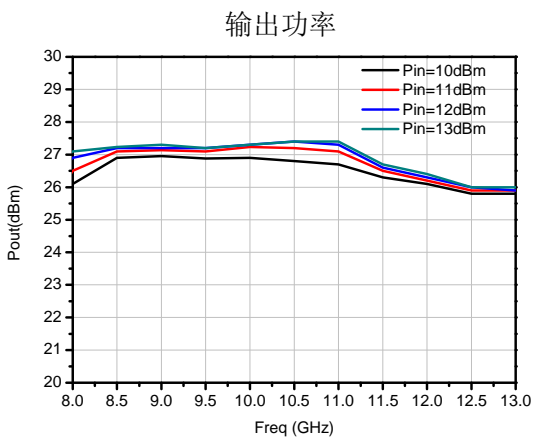
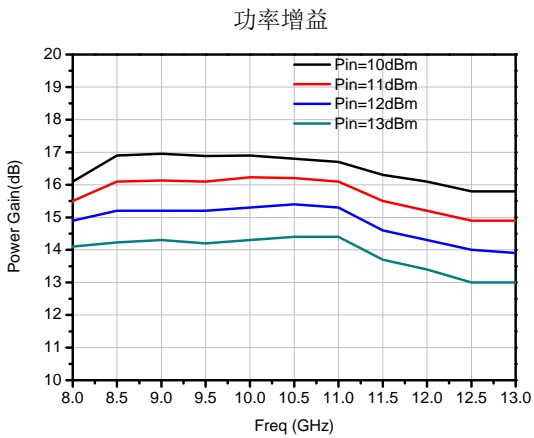
产品简介

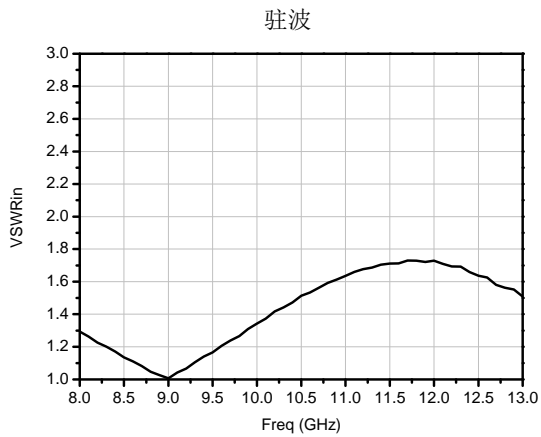
HG125F7 是一款 8~13GHz 驱动放大器芯片，功率增益为 15dB，1dB 压缩点输出功率为 26dBm。采用双电源供电，输入输出端已集成隔直电容。

电性能 ($T_A=25\text{ }^\circ\text{C}$, $V_D=8\text{V}$, $V_G=-0.6\text{V}$, $I=140\text{mA}$, Pin=12 dBm, 连续波)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~13		
功率增益(dB)	-	15	-
增益平坦度(dB)	-	± 0.5	-
输入驻波	-	1.6	-
输出驻波	-	2	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	26	-
饱和输出功率(dBm)	-	26.5	-

典型测试曲线

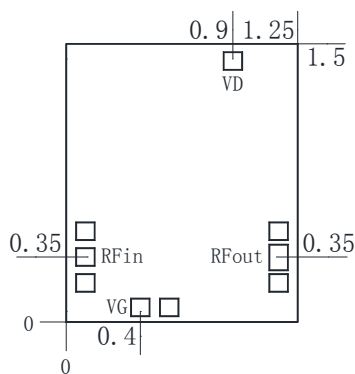




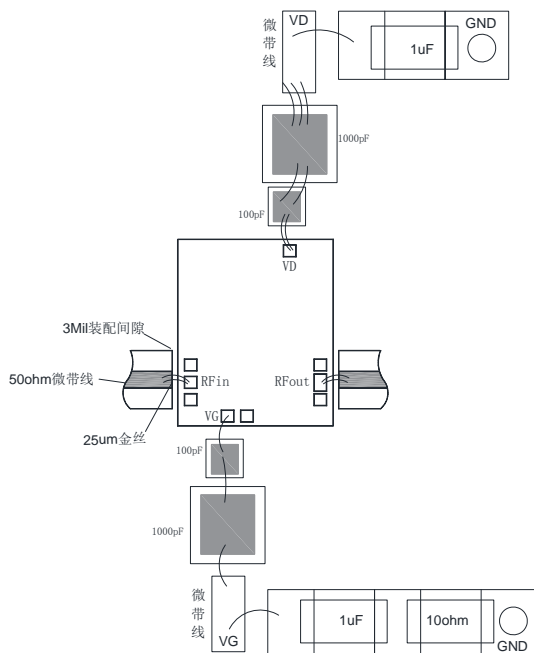
注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50μm 双金带键合，建议金带长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

电源电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃